

## § 31.7 マクスウェルの電磁方程式 (補足)

(真空中にて)	積分表現		微分表現
①ガウスの法則	$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{Q}{\epsilon_0}$	(31.12) $\Rightarrow$	$\text{div}\mathbf{D} = \rho$
②磁気に関するガウスの法則	$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} = 0$	(31.13) $\Rightarrow$	$\text{div}\mathbf{B} = 0$
③ファラデーの法則	$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = -\frac{d\Phi_m}{dt}$	(31.14) $\Rightarrow$	$\text{rot}\mathbf{E} = -\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t}$
④アンペール・マクスウェルの法則	$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 I + \epsilon_0 \mu_0 \frac{d\Phi_e}{dt}$	(31.15) $\Rightarrow$	$\text{rot}\mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial\mathbf{D}}{\partial t}$

上記の①～④のマクスウェルの電磁方程式を積分表現から微分表現に書き直す。

① ガウスの法則  $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{Q}{\epsilon_0}$

ガウスの定理より  $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \int \text{div}\mathbf{E}dV$  (閉曲面  $A$ , それが囲む領域  $V$ )

また, 閉曲面の電荷の総量を  $Q[\text{C}]$ , 電荷密度  $\rho[\text{C}/\text{m}^3]$  とすれば  $Q = \int \rho dV$  より  $\frac{Q}{\epsilon_0} = \frac{1}{\epsilon_0} \int \rho dV$

よってガウスの法則  $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{Q}{\epsilon_0}$  は次のように書き直すことが出来る

$$\int \text{div}\mathbf{E}dV = \frac{1}{\epsilon_0} \int \rho dV \quad \therefore \text{div}\mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

ここで電束密度  $\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E}$  (真空中)を代入すると,  $\therefore \text{div}\mathbf{D} = \rho$  ...①

② 磁気に関するガウスの法則  $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} = 0$

ガウスの定理より  $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} = \int \text{div}\mathbf{B}dV = 0$

よって磁気に関するガウスの法則  $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} = 0$  は次のように書き直すことが出来る

$$\therefore \text{div}\mathbf{B} = 0 \quad \dots\text{②}$$

③ ファラデーの法則  $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = -\frac{d\Phi_m}{dt}$

ストークスの定理より  $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \int \text{rot}\mathbf{E} \cdot d\mathbf{A}$  (閉曲線を周辺とする曲面  $A$ )

また、曲面  $A$  を通過する磁束  $\Phi_m$  は磁束密度  $\mathbf{B}$  を用いて表現すると  $\Phi_m = \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A}$  より  $\frac{d\Phi_m}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A}$

よってファラデーの法則  $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = -\frac{d\Phi_m}{dt}$  は次のように書き直すことができる

$$\int \text{rot}\mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = -\frac{\partial}{\partial t} \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} \qquad \therefore \text{rot}\mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad \dots \textcircled{3}$$


---

④ アンペール・マクスウェルの法則  $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 I + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{d\Phi_e}{dt}$

ストークスの定理より  $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \int \text{rot}\mathbf{B} \cdot d\mathbf{A}$

電流を  $I[\text{A}]$  を電流密度  $\mathbf{J}[\text{A}/\text{m}^2]$  で、電束  $\Phi_e$  を電界  $\mathbf{E}$  で表現すると  $I = \int \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A}$ ,  $\Phi_e = \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A}$  より

$$\mu_0 I + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{d\Phi_e}{dt} = \mu_0 \int \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A} + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial}{\partial t} \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \mu_0 \left( \int \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A} + \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} \right)$$

よってアンペール・マクスウェルの法則  $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 I + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{d\Phi_e}{dt}$  は次のように書き直すことができる

$$\int \text{rot}\mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} = \mu_0 \left( \int \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A} + \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} \right) \qquad \therefore \text{rot}\mathbf{B} = \mu_0 \left( \mathbf{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right)$$

ここで電束密度  $\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H}$ ,  $\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E}$  (真空中)を代入すると,  $\therefore \text{rot}\mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad \dots \textcircled{4}$

---